



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种改善电弧离子镀沉积工艺的动态磁控弧源装置

文献类型: 专利

作者 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 官骏, 杜昊, 赵彦辉, 杨英 and 闻立时

发表日期 2008-12-03

专利国别 中国

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本实用新型涉及薄膜制备领域,具体地说是一种新型的改善电弧离子镀沉积工艺的动态磁控弧源装置。所述改善电弧离子镀沉积工艺的动态磁控弧源装置设有动态控制磁场发生装置、靶材、靶材底座,靶材安装于靶材底座上,动态控制磁场发生装置为主控磁场发生装置和辅助磁场发生装置构成,主控磁场发生装置放置于靶材后面,和靶材同轴放置,辅助磁场发生装置套在可控磁场发生装置周围。本实用新型通过两组磁场发生装置配合使用,在靶面上形成动态分布的拱形磁场,达到改善弧斑的放电形式和工作稳定性,控制弧斑的运动轨迹,提高靶材刻蚀均匀性和靶材利用率,减少靶材大颗粒的发射...

公开日期 2008-12-03

语种 中文

专利申请号 CN201158702

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66810] [↓](#)

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 官骏, 杜昊, 赵彦辉, 杨英 and 闻立时. 一种改善电弧离子镀沉积工艺的动态磁控弧源装置. **GB/T 7714** 2008-12-03.

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
96	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。